			育2学期 《	电力	电子	技术》	考记	式试,	题
二0一八~	=0-	九学年第	月2日	试卷类	类型: B		试卷代号	号: 0分	oxy
考试	日期: 		月少日学号			姓名	九	+	总分
题号 一	=	Ξ	四五	六	七	八	76	,	
本题分数	24	] -,	不定项	选择题	į: (24	分)			
得 分									
(4') 在下列环 译的器件是( 子参与导电的全 品闸管(SCR .(2') 以管承关 品闸性负载, 品电阻性负载, C. 变压器不存在	(	适用于高 ‡是( 功 波 可 压 方 河 顶 压 方 河 顶 压 方 河 顶 压 方 河 顶 压 方 河 顶。	频(数十千 Hz )。 合; C. 功率 流电路叙述正 Ū2(U2 为变压 制角 α 越大, 时移相范围为	z)工作的 医晶体管( 强晶体管( 强	可控型器 GTR);	B件是( D. MC )。 (值);	OSFET;	,只有-	
3. (2') 以下关于 A. 晶闸管承受信 B. 适用于低压 C. 电阻性负载 D. 复责电压	为最大反向 大电流应用	电压为√6	U2为变压	为是 ( 器副边村	)。	效值);	re		

4. (2') 在三相半波逆变电路中, 叙述正确的是 ( )。  4. (2') 在三相半波逆变电路中, 叙述正确的是 ( )。	
4. (2') 在三相半波逆变电路中,从之上 4. (2') 在三相半波逆变状态,必须依次触发晶闸管 $T_a, T_b$ 和 $T_c$ ;	
大大型工作于逆变状态, 也可以实现有源逆变;	
B. 若在输出端接续流二极管,	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
D. 换相重叠使输出电压。	
5. (2') 下列关于 MOSFET 和 IGBT 叙述正确的是 ( )。	
ICPT 是 MOSFET 和 GTR 的复合结构;	
B. MOSFET 的密勒效应是由于其寄生电容引起;	
C. MOSFET 无二次击穿问题;	
D. IGBT 关断损耗较大是由于其存在电流拖尾现象。	
6. (2') 在 Buck 变换器中, 当负载电流为 10A 时, 输出滤波电感电流临界连续。	。假设占空比保持
不变。 若设计变换器在负载电流为 2A 时工作在电流临界连续模式,则需要(	).
A. 增大输出滤波电感; B. 增大开关频率;	
C. 增大输出滤波电容; D. 增大负载电阻。	
大工工图或别表达在格图内 屋工夕日休篼内窗内吸的目/	) 同工师南到
7. (4') 在下列隔离型直流变换器中,属于多晶体管功率电路的是(buck-boost 变换器的是( )。晶体管电压应力大于输入电压的是(	
它辅助电路,变压器磁通即可实现自动复位的是( )。	); 儿而增加共
A. 单端正激变换器; B. 推挽变换器; C. 反激变换器; D. 半桥变换器; E. 全桥变换器。	
上, 主机文换品。	
8. (2') 关于功率晶体管的 RCD 关断缓冲电路,以下叙述正确的是 ( )。	
A. 该关断缓冲电路目的是提高变换 B. (4) 一次	
A. 该关断缓冲电路目的是提高变换器的可靠性。 B. 该关断缓冲电路一定会恶化开通负载线;	
一 增大缓冲电容, 其他参数工士	
D. 当电阻变大, 其它条件不变, 开关管的关断损耗将会变小;	
人居开 <b>进</b> 损耗将会变大。	

- Q(2') 关于场控器件(MOSFET 或 IGBT)的驱动电路,下列叙述正确的是( A. 由于MOSFET 和 IGBT 栅极均为绝缘栅型结构,因此对驱动电流无要求;
- B. Buck 变换器中驱动电路无需隔离(假设控制电路无隔离):
- C. 互补式驱动电路中的两只三极管管型(NPN 或 PNP)相同; D. 为防止误导通,驱动电路最好能提供负的栅源极(或栅极-发射极)电压。
- )0 10.(2') 关于功率变换器中的磁性元件,下列叙述正确的是(
- A. 反激变换器中磁芯工作轨迹与负载电流有关;
- B. 正澈变换器中磁芯工作轨迹与负载电流有关;
- C. 磁芯加入气隙后磁导率下降;
- D. 改变开关频率的设计值对磁性元件体积无影响。

本题分数	30
得 分	

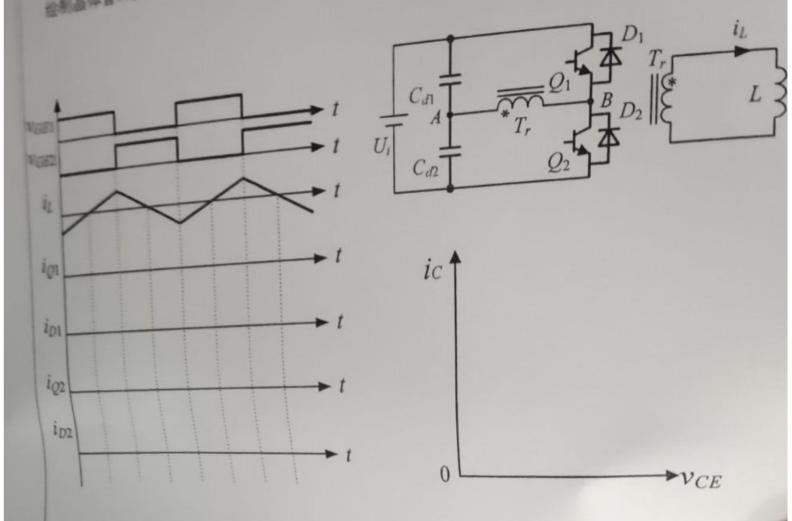
二、绘图题 (30分):

(3') 绘制 N 沟道增强型 MOSFET 的电工符号图,并画出其寄生电容。

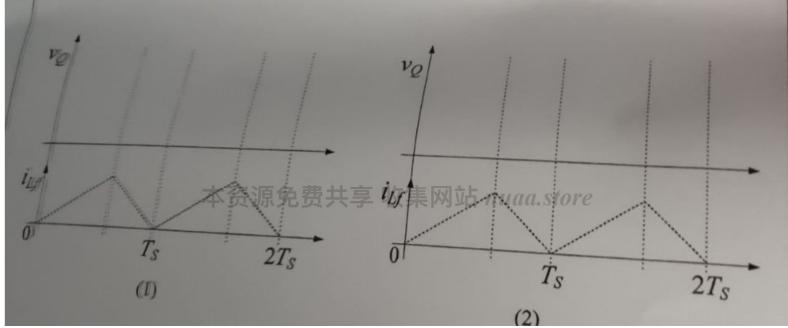
(5') 绘制带有RCD 缓冲电路的反激变换器电路图。

(6) 辛菸太逆交器,负载为德电感,晶体管为 IGBT (可认为是理想器件,

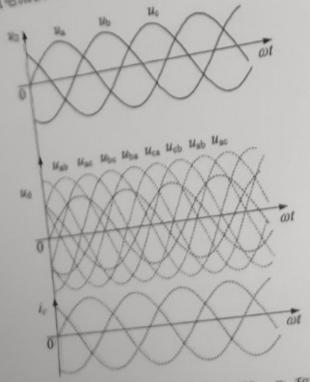
金融量体管和反并二极管的电流波形,并画出晶体管的开通关断负载线。



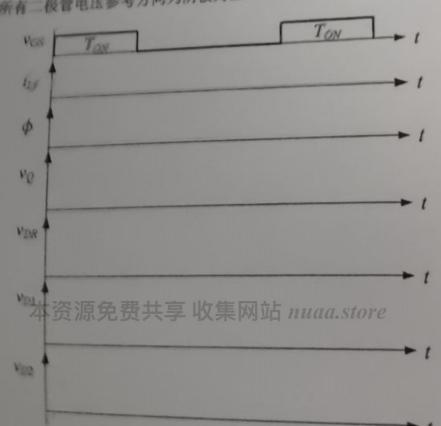
- 4. (4') Buck 变换器中,输入输出电压分别为  $U_i$ 和  $U_o$ ,晶体管的占空比为  $D_o$  在  $P_o=20$ W 时, 滤波电感电流如下图虚线所示。
  - (1) 当  $P_o = 10W$  时,如果  $U_i$  和 D 保持不变,绘制开关管电压波形和滤波电感电流波形;
  - ② 当 $P_s = 10W$ 时,如果 $U_s$ 和 $U_s$ 保持不变,绘制开关管电压波形和滤波电感电流波形。



(1) 三和粉式聚焦电路, 大电感负载, 控制角 α=30°, T-c 所在支路的熔断器熔断, 画出输出 格達電压液率和 和榮顯 电流波形(电流参考方向向右)。



(8') 单端正微变换器。Q为开关管。DR为磁复位二极管,D1和 D2分别为整流二极管和续流 二极管, Um300V, Um30V, Ni: N2: N3=3:1:3。要求绘制<u>断续模式下</u>的滤波电感电流波形、变压 数据透波影以及所有功率器件的电压波形。并<u>标注电压幅值</u>。(假定滤波电感电流在磁复位结 一极管电压参考方向为阴极为正、阳极为负)



46

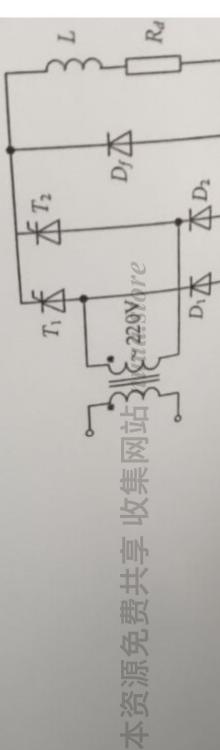
本题分数

综合计算题 (46分)

, (10°) 如图所示单相桥式半控整流电路, 负载为大电感性并接有续流二极管。采用 220V 交流

电网供电,要求输出整流电压 0~150V 连续可调, 负载电流为 50A。

- (1) 说明续流二极管的作用?
- (2) 计算晶闸管的导通角范围;
- (3) 计算整流电压为150V 情况下的晶闸管电流有效值和续流二极管电流有效值;
  - (4) 计算变压器容量



## 第7页(共10页)

2. (14') Boost 变换器, 其输入/输出参数为: U/=100V, U<sub>o</sub>=200-400V, I<sub>o</sub>=2A~10A, 开关频率

f=100kHz。假设功率变换器没有任何损耗。

- (1) 采用伏秒积平衡推导输入输出电压关系式;
- (2) 若整个范围内均工作在 CCM 模式, 求占空比变化范围及所需的电感最小值;
- (3) 晶体管和二极管类型?
- (4) 若整个范围内均工作在 DCM 模式, 求所需的电感最大值;
- (5) 开环状态下, 该变换器输出开路, 输出电压会无穷术, 请解释其物理概念(勿用数学表达

R.F-102, 周月4电压

3. (12') 如图所示具有续流二极管的三相半迭可控整流电路, 大电感负载,

 $U_2 = 110V$ ,  $\alpha = 45^{\circ}$ .

(1) 推导输出整流电压的表达式,必须给出推导过程;

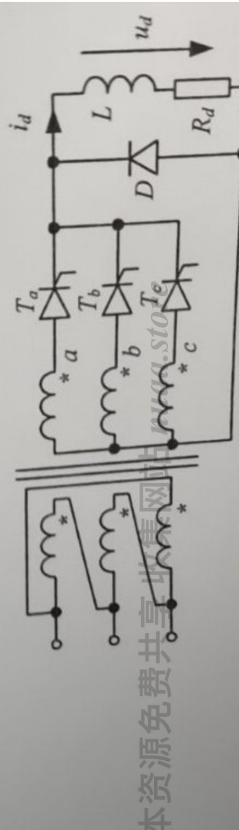
(2) 计算输出电压、电流平均值;

(3) 计算晶闸管电压、电流定额, 考虑安全裕量为 2, 选择晶闸管型号(给出额定电压电流值);

(4) 计算续流二极管电压、电流定额, 考虑安全裕量为2, 选择续流二极管型号(给出额定电

压电流值);

(5) 该电路中变压器和电感磁芯分别工作在哪种工作状态? 应该选用什么样的磁性材料?



(1) 请在电路图中画出 Q1(Q2)导通和截止时原边电流流通路径; 4 (10) 如图所示双管正微直流变换器, 变压器原副边匝比为 K。

(3) 輸入电压为 100V, 输出电压为 20V, 最大输出功率为 500W, 最小输出功率为 500W, 开

(4) 假设输入电压变化范围为 200V±20%, 输出电压为 40V, 设计变压器 匝比 K 并计算 占空比 关频率为100kHz, K=2, 滤波电感为100uH, 计算原边晶体管的电流峰值和电流有效值最

变化范围(电流连续)。

